



## CF-T19 Oxford PECVD 儀器簡介

### ○系統介紹

- .設備名稱：電漿輔助化學氣相沉積系統(Oxford PECVD)
- .設備廠牌：Oxford
- .設備型號：100 PECVD cassette system
- .設備功能：沉積介電薄膜 Deposition Film
- .設備構造：(如圖一)
  - Load lock Chamber
  - Transfer Chamber
  - Process Chamber

### ○功能介紹

- .設備功能：
  - Process Chamber 1：SiH<sub>4</sub>-SiO<sub>x</sub>、SiH<sub>4</sub>-SiN<sub>x</sub>
- .適用製程：
  - 6吋~8吋晶圓、4吋與破片需用載盤
- .製程溫度：
  - Process Chamber 1：300°C

### ○系統限制

基材含有下列金屬成份 Cu, Au, Ag, Fe, Pt 以及基材曾經進入過 Cu、Au、Ag、Fe、Pt 製程環境者，嚴禁進入本機台。



NAR Labs 國家實驗研究院

台灣半導體研究中心

Taiwan Semiconductor Research Institute



圖一. 設備構造